

Family list**3** family members for: **JP8111285**

Derived from 2 applications

**1 MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT
AND ITS DEVICE****Inventor:** ARAI MICHIO; NAKATANI KENJI; (+1) **Applicant:** TDK CORP**EC:** **IPC:** H05B33/10; H01L51/50; H05B33/12 (+7)**Publication info:** JP3520024B2 B2 - 2004-04-19

JP2000306666 A - 2000-11-02

**2 MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT
AND ITS DEVICE****Inventor:** ARAI MICHIO; NAKATANI KENJI; (+1) **Applicant:** TDK CORP**EC:** **IPC:** H05B33/04; C23C14/56; H01L51/50 (+14)**Publication info:** JP8111285 A - 1996-04-30

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

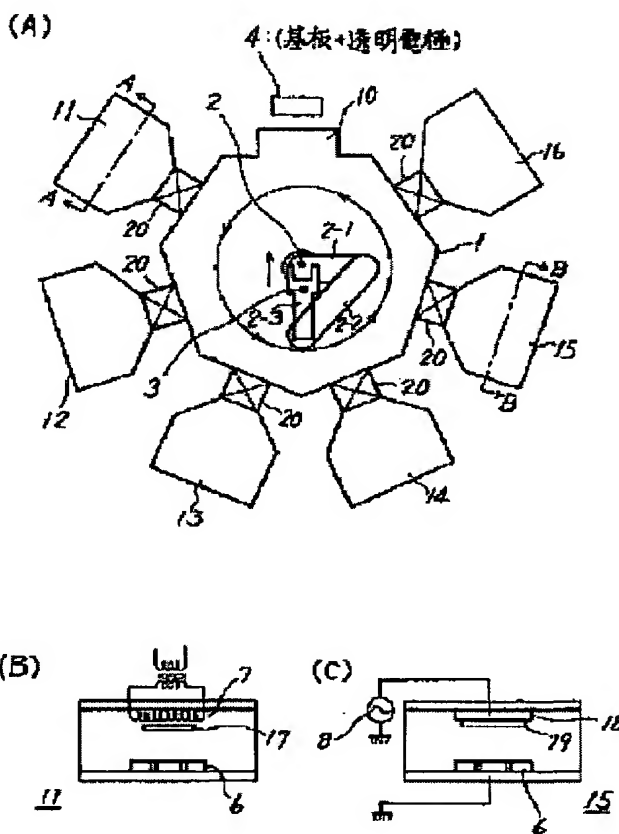
MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ITS DEVICE

Patent number: JP8111285
Publication date: 1996-04-30
Inventor: ARAI MICHIO; NAKATANI KENJI; NANBA NORIYOSHI
Applicant: TDK CORP
Classification:
- international: *H05B33/04; C23C14/56; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/12; H05B33/14; H01L51/56; H05B33/04; C23C14/56; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/12; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/10; C23C14/56; H05B33/04; H05B33/14*
- european:
Application number: JP19940244244 19941007
Priority number(s): JP19940244244 19941007

Report a data error here

Abstract of JP8111285

PURPOSE: To establish a method and device for manufacturing organic EL elements through such procedures that the process after formation of a transparent electrode on a base board till formation of a protection film is conducted continuously in vacuum chambers while isolated from the outer oxidative atmosphere followed by taking-out to the outside atmosphere after formation of protection film.
CONSTITUTION: A plurality of stratified parts of at least one portion of an organic electroluminescent element are subjected to film formation one after another in a plurality of vacuum chambers for working 11-16 which are provided around a vacuum chamber 1. The resultant is taken out upon formation of a protection film.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-111285

(43) 公開日 平成8年(1996)4月30日

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

F I

H05B 33/10

C23C 14/56

H05B 33/04

33/14

G 8939-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全6頁)

(21) 出願番号 特願平6-244244

(22) 出願日 平成6年(1994)10月7日

(71) 出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 中谷 賢司

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 南波 憲良

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(74) 代理人 弁理士 山谷 皓榮 (外2名)

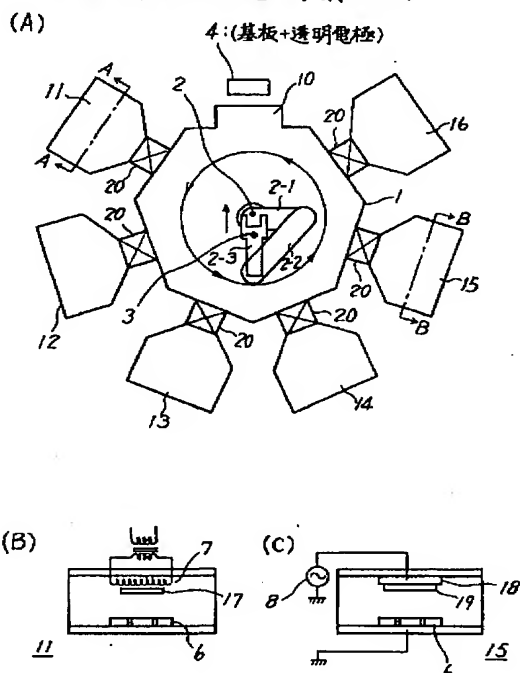
(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス素子の製造方法及びその装置

(57) 【要約】

【目的】 基板上に透明電極を形成した後の工程から保護膜形成の工程までを外気の酸化雰囲気から隔離して、連続して真空室中に行い、保護膜形成後に外気中に出すようにした有機EL素子の製造方法及び装置を提供すること。

【構成】 有機エレクトロルミネセンス素子の少なくとも一部の、複数の層状部分を、真空槽1の周辺に形成された複数の作業用真空室11~16において順次成膜し、保護膜の形成後に外部に取出すようにした。

本発明の一実施例構成図



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 有機エレクトロルミネセンス素子の少なくとも一部の複数の層状部分を、真空槽の周辺に形成された複数の作業用真空室において順次成膜し、保護膜の形成後に外部に取出すようにしたことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子の製造方法。

【請求項 2】 その内部に保持搬送手段を有する真空槽と、この真空槽の周囲に、有機エレクトロルミネセンス素子を構成する層状部分を形成する複数の作業用真空室を設け、

前記作業用真空室において有機エレクトロルミネセンス素子の一層を形成したことを特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子の製造装置。

【請求項 3】 前記真空槽内に、その先端部が各作業用真空室内に自由に移動できる可動アームを設けたことを特徴とする請求項 2 記載の有機エレクトロルミネセンス素子の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は有機エレクトロルミネセンス (EL) 素子の製造方法及びその装置に係り、特に有機エレクトロルミネセンス素子の製造に際し、基板上に透明電極を形成した後の工程から保護膜形成の工程までを、外気の酸化雰囲気から隔離して連続して真空室中に行い、保護膜形成後、外気中に取出すようにしたものに関する。

【0002】

【従来の技術】 有機 EL 素子は、薄形の新しい発光源として注目されている。従来有機 EL 素子を製造するために、図 4 に示す如く、ガラス基板 30 上に ITO の如き透明電極 31 を蒸着又はスパッタリングにより形成してこれをパターニングしたあと、真空室にこの透明電極 31 の形成された基板を配置して透明電極 31 の上に、正孔注入輸送層 32、発光層 33、電子注入輸送層 34、陰極 35、Si 層 36、保護膜 37 を蒸着させたり、あるいはスパッタリングにより順次形成していた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 従って、正孔注入輸送層 32、発光層 33、電子注入輸送層 34、陰極 35、Si 層 36、保護膜 37 を形成するために、その度に真空室を常圧に戻してそれぞれの工程に適した材料を入れ、真空にしたあと蒸着あるいはスパッタリングさせることが必要であった。

【0004】 そのため、各工程の度に常圧に戻すことが必要となり酸化雰囲気に露出されたり、製造時間が長くなるという欠点があった。従って本発明の目的は、前記各工程毎に一旦常圧に戻す必要のない有機 EL 素子の製造方法及びその装置を提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】 前記目的を達成するため、本発明では、図 1 に示す如く、中空柱状の真空槽 1 に、基板挿入取出部 10 と、複数の作業用真空室 11 ~ 15 を円周上に配置する。そして真空槽 1 の中央部分には、ロボット 2 を設置する。ロボット 2 には、上下左右方向に伸縮回転可能に構成された例えば 3 本のアーム 2-1、2-2、2-3 が設けられ、そのアーム 2-3 の先端には保持部 3 が形成されている。

【0006】 作業用真空室 11 ~ 16 は蒸着室あるいはスパッタリング室として構成される。蒸着室は、図 1 (B) に断面が示されるように、支持基部 6、加熱部 7、蒸着源 17 等が備えられ、支持基部 6 上に、後述するように載置された有機 EL ウェーハ 4 に蒸着源からの物質が被膜される。スパッタリング室は、図 1 (C) に断面が示されるように、支持部 6 と電極 18、ターゲット 19 が用意され、電極 18 には高周波源 8 が接続される。

【0007】

【作用】 先ず、ガラス基板に透明電極を形成してこれをパターニングした有機 EL ウェーハ 4 を後述する保持部に保持させたあと、これを基板挿入取出部 10 を開き、真空室 11 内のロボット 2 の保持部 3 に保持させる。このようにして有機 EL ウェーハ 4 を保持させたあと、これを真空槽 1 内に入れ、真空にする。

【0008】 それから作業用真空室 11 のゲート 20 を開き、有機 EL ウェーハ 4 をその支持部 6 に保持させて正孔注入輸送層を蒸着させる。次にロボット 2 はこの有機 EL ウェーハ 4 を作業用真空室 12 の支持部 6 に保持させ、発光層を蒸着させる。このようにして作業用真空室 13 にて電子注入輸送層を蒸着し、作業用真空室 14 にて陰極を蒸着し、作業用真空室 15 にて Si 層をスパッタリングし、作業用真空室 16 にて保護膜をスパッタリングで形成したあと、真空槽 1 を常圧に戻し、基板挿入取出部 10 から有機 EL 素子を取り出すことができる。

【0009】

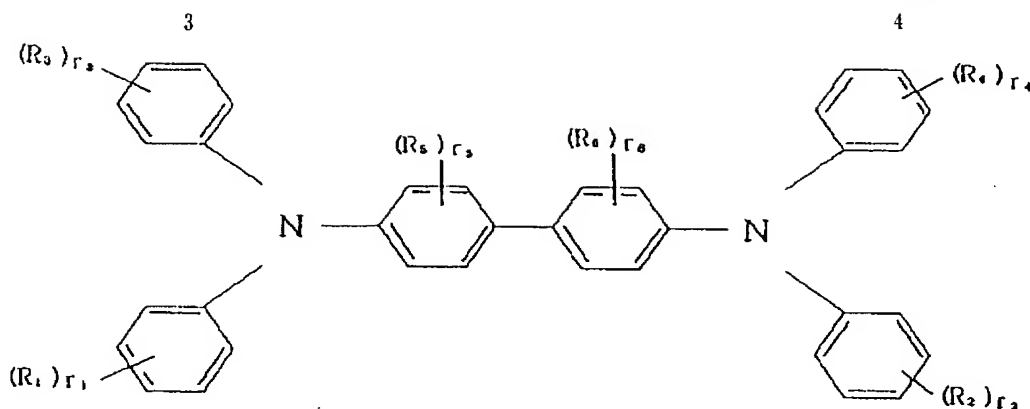
【実施例】 本発明の一実施例を図 1、図 2 及び図 4 にもとづき説明する。図 1 は本発明の一実施例構成図、図 2 は本発明の作業用真空室とロボット 2 の保持部 3 の要部説明図、図 4 は有機 EL 素子の構成を示す。

【0010】 先ず図 4 により有機 EL 素子の製法について説明する。透明電極 31 は陽極となるものであって例えば ITO 等で構成され、ガラス基板 30 上に蒸着又はスパッタリングにより成膜されたあとパターニングされて所定の形状に整形されたもの、あるいはマスタパターニングされて所定の形状に成膜されたものである。

【0011】 正孔注入輸送層 32 は、例えば下記化 1 で表されるテトラアリールジアニン誘導体が使用される。

【0012】

【化 1】

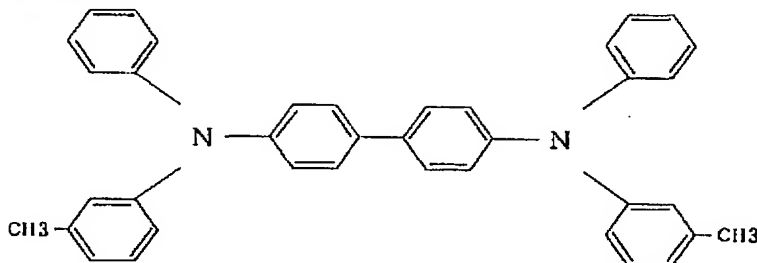


【0013】〔化1において、 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 はそれぞれアリール基、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基、又はハロゲン原子を表す。 r_1 、 r_2 、 r_3 及び r_4 は、それぞれ0又は1～5の整数である。 R_5 及び R_6 は、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、又はハロゲン原子を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 r_5 及び r_6 は、それぞれ0又は1～4の整数である。〕

この化1に限定されず、例えば下記化2で表されるN、N'-ジ(3-メチルフェニル)-N、N'-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニルを蒸着することにより形成したものを正孔注入輸送層22として使用することもできる。

【0014】

【化2】



【0015】この外、芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフェン等が使用できる。

【0016】発光層33は、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム等の金属錯体色素、テトラフェニルブタジェン、アントラセン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリノン誘導体、キナクリドン、ルブレン、スチリル系色素等の有機蛍光体や、前記正孔注入輸送層32を構成する例えば化1で表されるテトラアリールジアミン誘導体と、後述する電子注入輸送層34を構成する例えばトリス(8-キノリノラト)アルミニウムとの混合物が使用される。この場合、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着が好ましいが、これに限定されるものではない。勿論蛍光性物質を含ませることもできる。

【0017】電子注入輸送層34は、例えばトリス(8-キノリノラト)アルミニウム等の金属錯体色素、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレン誘導体等を蒸着することにより形成される。

【0018】陰極35は、仕事関数の小さい材料例えばLi、Na、Mg、Al、Ag、Inあるいはこれらの

1種以上を含む合金例えばMgAg(例えば重量比10:1)、MgIn等で構成される。陰極35は蒸着又はスパッタリングにより成膜される。

【0019】Si層36は陰極35をコーティングしてその酸化を防止するものであり、Siをスパッタリングすることで成膜される。保護膜37は陰極35の酸化防止のみならず、正孔注入輸送層32～電子注入輸送層34の酸化を防止し、有機EL素子が長時間発光できるようにするものであり、例えばSiO₂、Si₃N₄等をスパッタリングすることにより形成される。

【0020】本発明では、前記正孔注入輸送層32～保護膜37の形成を図1(A)に示す作業用真空室11～16で順次行うものである。次に図1(A)に示す本発明の製造装置について説明する。図1(A)において、1は真空槽、2はロボット、3は保持部、4は有機ELウェーハ、10は基板挿入取出部、11～16は作業用真空室、20はゲートバルブである。

【0021】真空槽1は、有機EL素子をガラス基板30に透明電極31を形成したものから、正孔注入輸送層32、発光層33、電子注入輸送層34、陰極35、Si層36、保護膜37を形成されるまでを連続的に行うものであり、内部にロボット2が設置され、また真空槽1の周壁には作業用真空室11～16が、クラスタ状に

配置されている。また真空槽 1 には基板挿入取出部 1 0 が形成されている。

【0022】ロボット 2 は、有機 E L ウェーハ 4 を順次作業用真空室 1 1 ~ 1 6 に挿入し、取出すものであり、例えば 3 本のアーム 2 - 1、2 - 2、2 - 3 を有する。これらのアーム 2 - 1 ~ 2 - 3 は、そのアーム 2 - 3 の先端に形成された保持部 3 が上下左右の 3 6 0 ° の全方向に移動回転可能に構成されている。

【0023】保持部 3 は、有機 E L ウェーハ 4 が保持された保持板 5 を載置するものであり、その先端には、後述する支持基部 6 の穴部 6 - 1、6 - 2 に進入される突出部 3 - 1、3 - 2 が形成されている。

【0024】有機 E L ウェーハ 4 は、有機 E L 素子が製造されるまでの中間体であり、図 1 (A) に示す有機 E L ウェーハ 4 はガラス基板 3 0 に透明電極 3 1 がパターンニング形成されたものであり、その後順次作業用真空室 1 1 ~ 1 6 で順次成膜されて、有機 E L 素子になるまでの途中のものをいう。

【0025】作業用真空室 1 1 は、例えば正孔注入輸送層 3 2 を蒸着する、蒸着工程用の真空室であり、図 1 (B) はその A - A 線断面図である。この断面図に示されるように作業用真空室 1 1 には支持基部 6、加熱部 7、蒸着源 1 7 が具備されている。作業用真空室 1 1 では正孔注入輸送層 3 2 が蒸着されるので、この室の蒸着源 1 7 には前記化 1 あるいは化 2 で示されるものが使用される。

【0026】支持基部 6 は、有機 E L ウェーハ 4 が保持された保持板 5 が載置されるものであり、図 2 に示す如く、穴部 6 - 1、6 - 2 が形成されている。図 2 の状態において、ロボット 2 の先端部 3 が右方向に移動し、その突出部 3 - 1、3 - 2 が穴部 6 - 1、6 - 2 に進入する。このとき、突出部 3 - 1、3 - 2 の上面が支持基部 6 の上面よりもわずかに高い状態で進入するので、保持板 5 はそのまま支持基部 6 上を移動する。そして所定の位置に進入したとき、先端部 3 が下降するので、保持板 5 は支持基部 6 上の所定の位置に載置される。

【0027】この状態で、ゲートバルブ 1 6 を閉じ、加熱部 7 に通電すれば、蒸着源 1 7 が有機 E L ウェーハ 4 上に蒸着される。そして蒸着終了後、再びゲートバルブ 2 0 を開き、ロボット 2 の先端部 3 の上面が支持基部 6 の上面よりも低い状態で突出部 3 - 1、3 - 2 が穴部 6 - 1、6 - 2 に進入させ、所定の位置に進入したとき、先端部 3 を若干上昇させる。これにより蒸着処理された有機 E L ウェーハ 4 が先端部 3 に再び載置される。これを作業用真空室 1 1 の外に移動し、次の作業用真空室 1 2 内の支持基部 6 上に同様に載置する。このようにして順次作業用真空室における成膜処理を行うことができる。なお図 2 に示す如く、マスク 9 を設け、マスク蒸着することもできる。

【0028】作業用真空室 1 2 は発光層 3 3 を蒸着する

ものであり、作業用真空室 1 3 は電子注入輸送層 3 4 を蒸着するものであり、作業用真空室 1 4 は陰極 2 5 を蒸着するものである。これらの各室は、前記作業用真空室 1 1 と同様に構成されている。

【0029】作業用真空室 1 5 は例えば S i 層 3 6 をスパッタリングにより形成するスパッタリング工程用の真空室であり、図 1 (C) はその B - B 断面図である。この断面図に示されるように、スパッタリング用の作業用真空室 1 5 でも、蒸着用の作業用真空室と同様に支持基部 6 が設けられている。そしてその上方に電極 1 8 が設置され、その前面にターゲット 1 9 が配置されている。電極 1 8 には高周波源 8 により高周波電圧が印加され、室内に発生した高周波放電によりターゲットがスパッタリングされ、支持基部 6 上に載置された有機 E L ウェーハ 4 上に S i 層 3 6 が形成される。このとき室内に A r ガスが導入されスパッタを行う。

【0030】作業用真空室 1 6 は、例えば保護膜 3 7 をスパッタリングにより形成するスパッタリング工程用の真空室であり、前記作業用真空室 1 5 と同様に構成されている。

【0031】なお、前記作業用真空室 1 1 ~ 1 4 及び作業用真空室 1 5、1 6 は、真空槽 1 の周辺に設置され、これらはいわゆるクラスター状に設置されている。最初にガラス基板 3 0 に透明電極 2 1 を形成した有機 E L ウェーハ 4 を保持板 5 に保持させ、これを基板挿入取出部 1 0 の窓部より入れてロボット 2 の先端部 3 上に載置する。それから各作業用真空室 1 1 ~ 1 6 のゲートバルブ 2 0 を開き、真空槽 1 を図示省略した真空ポンプにて排気する。

【0032】そして所定の気圧に減圧されたとき、ロボット 2 の先端部 3 を作業用真空室 1 1 に挿入し、その支持基部 6 上に有機 E L ウェーハ 4 を保持した保持板 5 を前記の如く載置したあと、そのゲートバルブ 1 6 を閉める。そして加熱部 7 を加熱し、蒸着源 1 7 から正孔注入輸送層 3 2 を蒸着させる。

【0033】このようにして正孔注入輸送層 3 2 が形成された後、作業用真空室 1 1 では、ゲートバルブ 2 0 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに正孔注入輸送層 3 2 が形成された有機 E L ウェーハ 4 が保持されている保持板 5 を、次に作業用真空室 1 2 内の支持基部 6 上に載置し、そのゲートバルブ 2 0 を閉める。そして加熱部 7 を加熱し、蒸着源 1 7 から発光層 3 3 を蒸着させる。

【0034】発光層 3 3 が形成された後、作業用真空室 1 2 ではゲートバルブ 2 0 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに発光層 3 3 が形成された有機 E L ウェーハ 4 が保持されている保持板 5 を、次の作業用真空室 1 3 内の支持基部 6 上に載置し、そのゲートバルブ 2 0 を閉める。そして加熱部 7 を加熱し、蒸着源 1 7 から電子注入輸送層 3 4 を蒸着させる。

【0035】このように電子注入輸送層 34 が形成された後、作業用真空室 13 ではゲートバルブ 20 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに電子注入輸送層 24 が形成された有機 E L ウェーハ 4 が保持されている保持板 5 を、次の作業用真空室 14 内の支持基部 6 上に載置し、そのゲートバルブ 20 を閉める。そして加熱部 7 を加熱し、蒸着源 17 から陰極 35 を蒸着させる。

【0036】陰極 35 が形成された後、作業用真空室 14 ではゲートバルブ 20 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに陰極 35 が形成された有機 E L ウェーハ 4 が保持されている保持板 5 を、次の作業用真空室 15 内の支持基部 6 上に載置し、そのゲートバルブ 20 を閉める。そして電極 18 に高周波源 8 より高周波を印加し、高周波放電を発生させ、ターゲット 19 をスパッタして有機 E L ウェーハ 4 上に S i 層 36 が形成される。

【0037】S i 層 36 が形成された後、作業用真空室 15 ではゲートバルブ 20 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに S i 層 36 が形成された有機 E L ウェーハ 4 が保持されている保持板 5 を、次の作業用真空室 16 内の支持基部 6 上に載置し、そのゲートバルブ 20 を閉める。そして電極 18 に高周波源 8 より高周波を印加し、高周波放電を発生させ、ターゲット 19 をスパッタして有機 E L ウェーハ 4 上に保護膜 37 を形成する。

【0038】このように保護膜 37 が形成された後、作業用真空室 16 ではゲートバルブ 20 を開き、ロボット 2 の先端部 3 を駆動して、それに保護膜 37 が形成された有機 E L 素子を保持されている保持板 5 を基板挿入取出部 10 に駆動させる。そして真空槽 1 内を常圧に戻し、図示省略した窓部を開いて有機 E L 素子を取り出す。

【0039】なお、前記説明では、支持基部 6 を各作業用真空室の下に位置した例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、図 3 (A) に蒸着用の作業用真空室 11' として代表的に示す如く、蒸着用の加熱部 7、蒸着源 17 を下方におき、支持基部 6 を上方においてもよい。同様に図 3 (B) に示す如く、スパッタリング用の作業用真空室 15' としては、電極 18 やターゲット 19 を下方におき支持基部 6 を上方においてもよい。

【0040】このとき、当然のことながら有機 E L ウェーハ 4 は蒸着源 17 あるいはターゲット 19 側に面している。そして支持基部 6 には、この有機 E L ウェーハ 4 の載置部分の下方に穴部が形成されている。

【0041】前記実施例では、有機 E L 素子として正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の 3 層構成の有機 E L 素子例について説明したが本発明は勿論これに限定されるものではない。例えば正孔注入輸送層・発光層・電子注入輸送層、正孔注入輸送層・電子注入輸送層・発光層の如きものに対しても同様に適用できる。また 1 つ

の電子注入層が発光層及び正孔注入層を兼ねる場合も本発明に含まれるものである。

【0042】また作業用真空室の配置は、その作業順に従って左廻りに配置した例について説明したが、作業用真空室の配置は作業順に限定されるものではなく、任意に配置できる。この場合、ロボット 2 の有機 E L ウェーハの駆動先が作業順に従って行われることになる。勿論作業順は右廻りでもよい。

【0043】作業用真空室の数も、図 1 (A) に示すものに限定されるものではなく、例えば層数の増加などにより工程数が増加すればこれに応じて増加することができる。

【0044】前記説明では陰極上に S i 膜を成膜したものに対してその上に保護膜を形成する場合について説明したが本発明はこれに限定されるものではなく、他のものについても勿論適用できる。

【0045】

【発明の効果】請求項 1 に記載された本発明によれば、真空を破らない、いわゆるクラスツール方式で有機 E L 素子を製造するので、一度真空にすれば工程が終わるまでこれを保持すればよく、工程毎に真空状態にする必要がないので効率的である。しかも保護膜を形成したあとで大気中に取出すので、各層が酸化雰囲気露出されることがないので、各層が酸化されないため、発光寿命の長いものを提供することができる。

【0046】請求項 2 に記載された本発明によれば各作業用真空室は個別の膜を形成するので、高価な有機 E L 材料を作業用真空室より回収して再利用することができる。請求項 3 に記載された本発明によれば各作業用真空室に自動的に有機 E L ウェーハを搬送して成膜し、極めて効率良く有機 E L 素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施例構成図である。

【図 2】作業用真空室の要部説明図である。

【図 3】本発明の他の実施例である。

【図 4】有機 E L 素子の 1 例である。

【符号の説明】

- 1 真空槽
- 2 ロボット
- 3 先端部
- 4 有機 E L ウェーハ
- 5 保持板
- 6 支持基部
- 7 加熱部
- 8 高周波源
- 9 マスク
- 10 基板挿入取出部
- 11 ~ 16 作業用真空室
- 17 蒸着源
- 18 電極

19 ターゲット

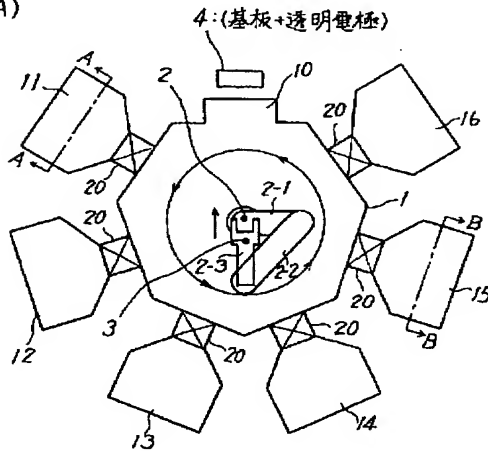
20 ゲートバルブ

【図1】

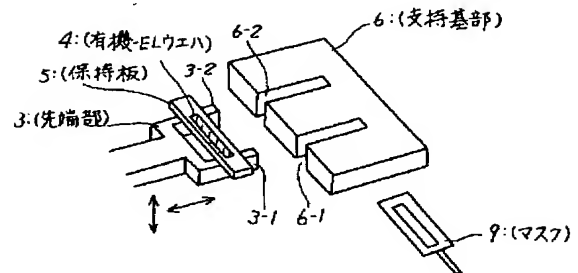
【図2】

本発明の一実施例構成図

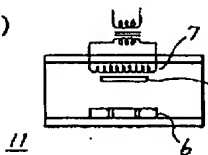
(A)



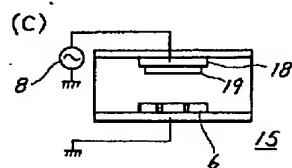
作業用真空室の要部説明図



(B)



(C)

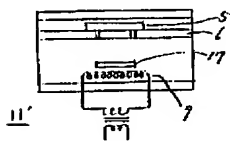


【図3】

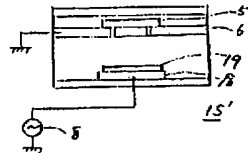
【図4】

本発明の第2実施例

(A)



(B)



有機EL素子

